



www.cnrs.fr

INSTITUT
FRANÇAIS



Visuels disponibles

Ces photos sont disponibles sur demande : phototheque@cnrs-bellevue.fr ou par commande directe en ligne : <http://phototheque.cnrs.fr>

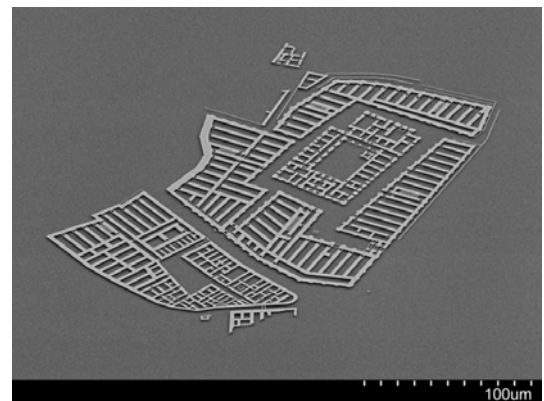
Exposition OnLAB, le musée des poussières

Mention obligatoire :

© CNRS Photothèque/LPN / Michel PAYSANT, Christian ULYSSE, Giancarlo FAINI



Hattusha, Grand Temple. Nano-fabrication par lithographie électronique $187\ \mu\text{m} \times 261\ \mu\text{m}$. Vue au microscope optique. Or sur silicium.

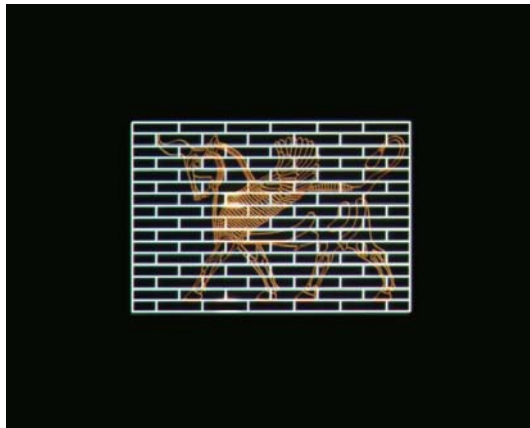


Hattusha, Grand Temple. Nano-fabrication par lithographie électronique $187\ \mu\text{m} \times 261\ \mu\text{m}$. Vue au microscope électronique à balayage. Or sur silicium.

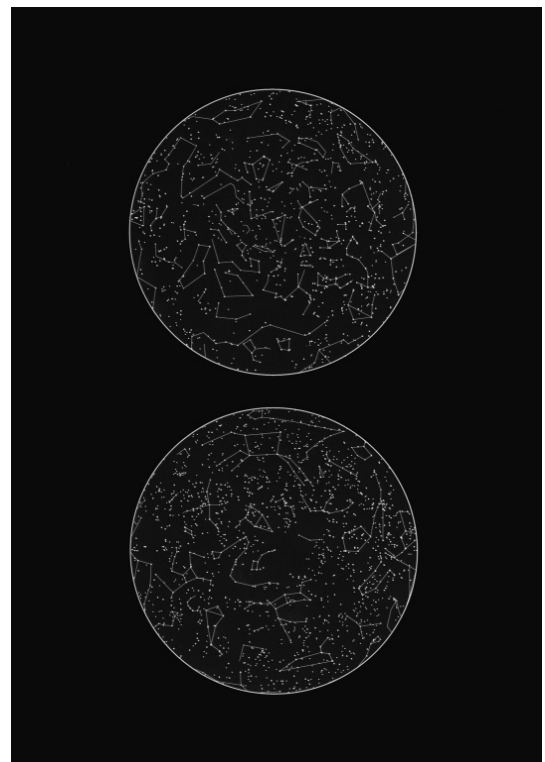


www.cnrs.fr

INSTITUT
FRANÇAIS



D'après Panneau décoratif en briques moulées,
SUSE, Musée du Louvre.
Nano-fabrication par lithographie électronique.
175 μm x 119 μm . Vue au microscope optique.
Polymère et or sur silicium.



Constellation I et II. Nano-fabrication par
lithographie électronique. Diamètres 180
 μm . Vue au microscope électronique à
balayage. Or sur silicium.



www.cnrs.fr

INSTITUT
FRANÇAIS



Plaque de silicium avec nanofabrication : tatouage maori. Nano-fabrication par lithographie électronique. $359\ \mu\text{m} \times 368\ \mu\text{m}$.
Vue au microscope optique. Or sur silicium.



Tatouage maori, Nouvelle-Zélande, vers 1800. Nano-fabrication par lithographie électronique. $359\ \mu\text{m} \times 368\ \mu\text{m}$.
Vue au microscope optique. Or sur silicium.



L'Arche de Noé, d'après une illustration d'une Bible de Luther datant de 1564. Nano-fabrication par lithographie électronique. $227\ \mu\text{m} \times 164\ \mu\text{m}$. Vue au microscope électronique à balayage. Or sur silicium.



L'Arche de Noé (détail), d'après une illustration d'une Bible de Luther datant de 1564. Nano-fabrication par lithographie électronique. $227\ \mu\text{m} \times 164\ \mu\text{m}$.
Vue au microscope électronique à balayage. Gravure sur silicium.



www.cnrs.fr

INSTITUT
FRANÇAIS



Le Laboratoire de photonique et de nanostructures (LPN)

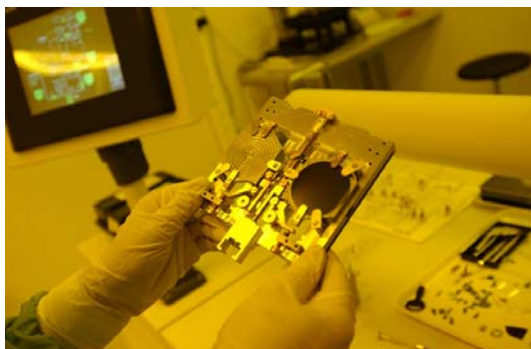
Mention obligatoire : © CNRS Photothèque / Jérôme CHATIN



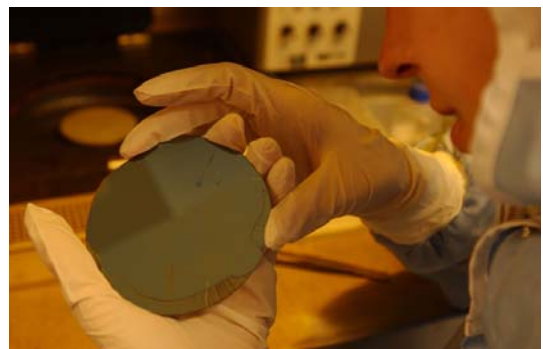
Travail en salle blanche de 1000 m² (classe 100) dont 300m² dédiés à la croissance de nanostructures semiconductrices III-V.



Bâti de croissance de nanostructures semiconductrices III-V par épitaxie par jets moléculaires (EJM) sous ultra-vide. Cette technique permet de déposer sur un substrat hôte de fines couches semiconductrices avec une précision de quelques plans atomiques (de l'ordre du nanomètre).



Travail en salle de lithographie électronique. La lithographie électronique est une étape indispensable pour la réalisation de masques optiques, ou pour l'écriture directe et la réalisation de nanostructures (10nm-100nm).



Contrôle visuel de la surface d'un échantillon après dépôt.